

## 19. ทรานซิสเตอร์ (transistor)

### 19.1 การแสดงเส้นโค้ง $I_C$ vs $V_{CE}$ ของทรานซิสเตอร์

บทความ การแสดงเส้นโค้ง  $I_C$  vs  $V_{CE}$  ของทรานซิสเตอร์ด้วยโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล

ธงชัย พันธุ์เมฆาฤทธิ์

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

#### บทคัดย่อ

ได้แสดงเส้นโค้ง  $I_C$  vs  $V_{CE}$  ของทรานซิสเตอร์ด้วยโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล

#### Abstract

$I_C$  vs  $V_{CE}$  curve of transistor was displayed with Turbo Pascal Program.

Key words : transistor

#### คำนำ

สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 เช่น Si และ Ge พาหะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล จำนวนอิเล็กตรอนกับจำนวนโฮลเท่ากัน สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำชนิด p และสารกึ่งตัวนำชนิด n พาหะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล

สารกึ่งตัวนำชนิด p ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับ อะตอมของธาตุกลุ่ม 3 เช่น Si ผสมกับ B จำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน ( $E_g$ ) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่ยังได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

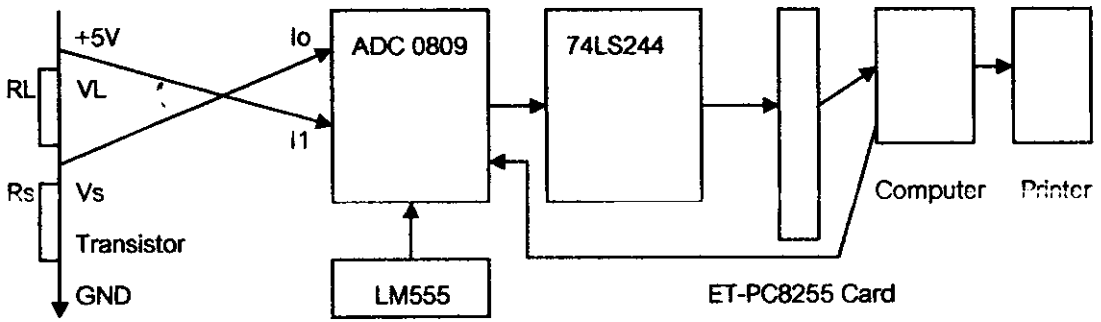
สารกึ่งตัวนำชนิด n ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับอะตอมของธาตุกลุ่ม 5 เช่น Si ผสมกับ As จำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่ยังได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

ทรานซิสเตอร์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p ต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิด n ทรานซิสเตอร์มี 2 แบบ คือ แบบ PNP และแบบ NPN ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าและทำหน้าที่เป็นสวิตช์ เมื่อนำทรานซิสเตอร์ไปต่อกับอุปกรณ์อื่นๆก็จะได้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า เกท (gate) ได้

#### วิธีการทดลอง

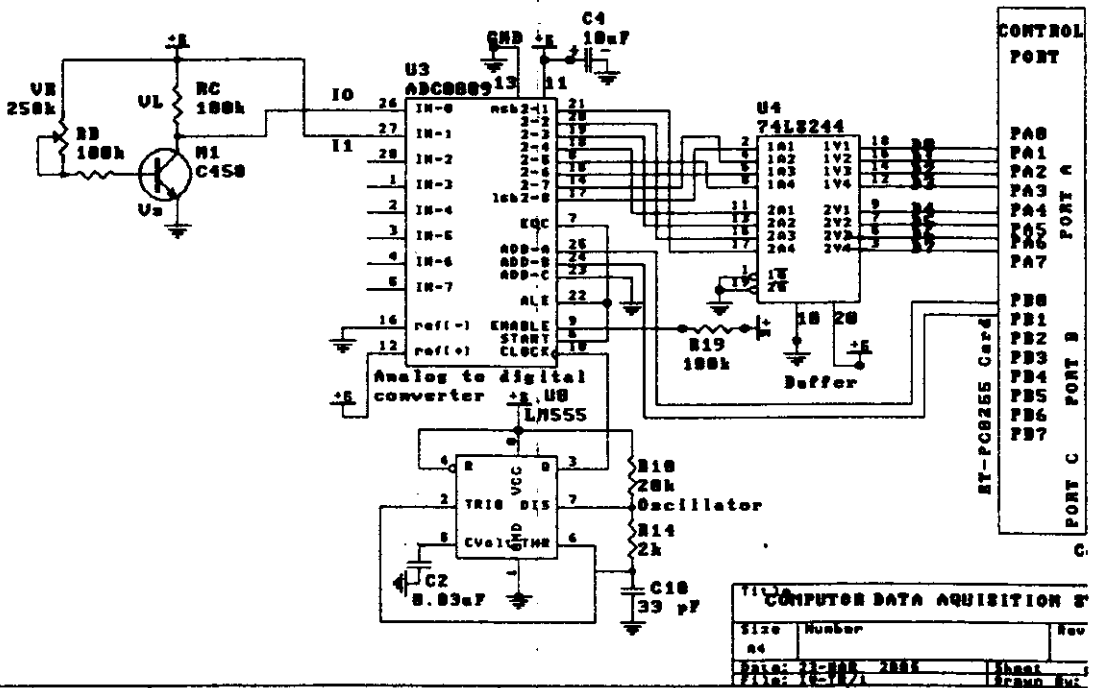
ได้อาศัยเทคนิคการเชื่อมต่อดังด้วยคอมพิวเตอร์จากประสบการณ์และเอกสารทั่วไป (George C. Barney, 1988) มาดัดแปลง แล้วเขียนเป็นบล็อกไดอะแกรมสำหรับแสดงเส้นโค้งกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1) เขียนบล็อกไดอะแกรม ประกอบวงจรและทดสอบจนใช้ได้ (รูปที่ 19.1.1)



รูปที่ 19.1.1(ก) บล็อกไดอะแกรมสำหรับให้คอมพิวเตอร์แสดงผลโค้งกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์

COMPUTER INTERFACING CIRCUIT BOARD FOR ICS VS VCE CURVE OF TRANSISTOR



รูปที่ 19.1.1(ข) วงจรสำหรับให้คอมพิวเตอร์แสดงผลโค้งกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์

2) เขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์แสดงผลโค้งกระแสไฟฟ้าที่ขึ้นกับแรงดันไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้  
 Program Current\_versus\_voltage\_graph\_for\_transistor;

uses crt, graph;

var

grdrv, gmode, gerror : integer;

ch : char;

const

PA = \$0304;

PB = \$0305;

```

Pcontrol = $0307;

Procedure axis;
var p, q : integer;
    tex : string;

begin
    grdrv := detect; initgraph(grdrv, gmode, 'C:\tp\lbgf');
    setgraphmode(gmode);
    setcolor(15); line(50,50,50,305); line(50,305,300,305);
        line(50,50,300,50); line(300,50,300,305);
    settextstyle(defaultfont, horizdir, 0);
    for p:=50 to 300 do
        if p mod 51 = 0 then
            begin
                line(p, 295, p, 305); str(-(((300-p) mod 5)-5), tex);
                outtextxy(p+50, 310, tex);
            end;
        setcolor(15); settextstyle(defaultfont, horizdir, 0);
    for q:=50 to 305 do
        begin
            if q mod 51 =0 then
                begin
                    line(45, q, 55, q); str((((305-q) mod 5)+1), tex);
                    outtextxy(20, q, tex);
                end;
            end;
        end;

procedure plot;
var j, k, x, y, DV1, DV2           : integer;
    AV1, AV2, R, RL, Vs, VLs, VL, iL, Is, V, I : real;

begin
    setcolor(3); outtextxy(205, 11, 'Current vs Voltage Curve');
    setcolor(3); outtextxy(205, 18, '_____');
    setcolor(5); outtextxy(50, 30, 'Current (mA)');
    setcolor(5); outtextxy(310, 320, 'Voltage (V)');
    setcolor(5); outtextxy(48, 303, "");
    Port[Pcontrol]:=90;
    RL:=220; {ohm}

```

```

for j:=1 to 100 do
begin
  for k:=0 to 550 do
  begin
    port[PB]:=0 {I0}
    delay(100);
    DV1 := port[PA]; {Vs}
    AV1 := (5/255)*DV1;
    Vs:=AV1;
    V:=Vs;
    port[PB]:=1 {I1}
    delay(100);
    DV2 := port[PA]; {VLs}
    AV2 := (5/255)*DV2;
    VLs:=AV2;
    VL:=(VLs-Vs);
    IL:=VL/RL;
    Is:=IL;
    I:=Is*1000; {mA}
    X:=round(50+(255/5)*V); y:=round(305-(255/50)*I);
    setcolor(15); line(x,y,x,y);
    delay(10)
  end;
end;
end;
begin
  repeat
  axis;
  plot;
  ch:=readkey;
  until ord(ch) = 27;
end.

```

### 3) สั่งให้เครื่องทำงาน

คอมพิวเตอร์จะส่งแรงดัน 0 V ออกทางพอร์ต B เพื่อให้ I<sub>0</sub> ทำงานและส่งแรงดัน 5 V ออกทางพอร์ต B เพื่อให้ I<sub>1</sub> ทำงาน (ของ ET-PC 8255 card) แรงดัน V<sub>s</sub> เข้าทางอินพุต I<sub>0</sub> และแรงดัน V<sub>Ls</sub> เข้าทางอินพุต I<sub>1</sub> ของ ADC 0809 เพื่อแปลงแรงดันอนาล็อก (AV) ให้เป็นแรงดันดิจิทัล (DV) (LM555 ทำหน้าที่ควบคุมให้ ADC 8255 ทำงาน) ส่งผ่านบัฟเฟอร์

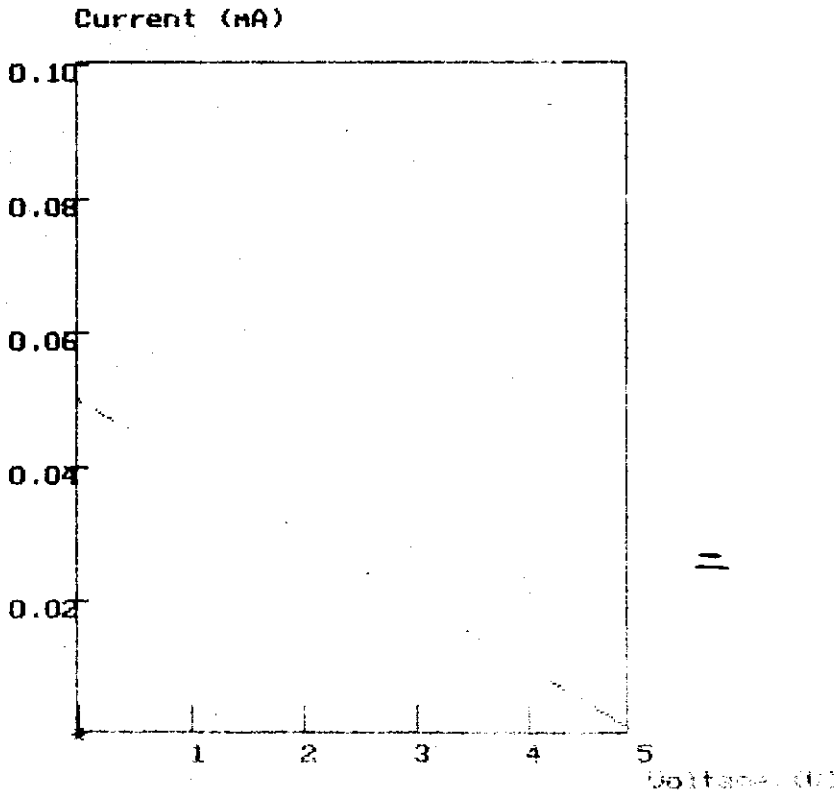
74LS244 และ พอร์ท A ของ ET-PC 8255 card แล้วเข้าคอมพิวเตอรื คอมพิวเตอรืจะอ่านแรงดันดิจิตอลแล้วแปลงเป็นแรงดันอนาลอก แรงดันอนาลอก คือ  $V_s$  และ  $V_Ls$  ให้  $V_s$  เป็น V แต่  $V_L=V_s-V_s$   $I_L=V_L/R_L$  ให้  $I_L$  เป็น I

5) ให้คอมพิวเตอรืแสดงกราฟ I vs V แล้วพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

ผลการทดลอง

เส้นโค้งกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์ที่แสดงบนจอคอมพิวเตอรืแสดงดังรูปที่ 19.1.2

$I_C$  vs  $V_{CE}$  Curve For Transistor



รูปที่ 19.1.2 เส้นโค้งกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์ที่จอคอมพิวเตอรื

วิเคราะห์ผลการทดลอง

เส้นโค้งกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์ที่บอกสมบัติเชิงไฟฟ้า

สรุปผลการทดลอง

ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอรืที่ควบคุมด้วย Turbo Pascal สามารถแสดงเส้นโค้ง  $I_C$  vs  $V_{CE}$  ของทรานซิสเตอร์

ด้วยโปรแกรมเทอร์โมปาสคาล

เอกสารอ้างอิง

Charles Kittel, 1976, Introduction to Solid State Physics, 5<sup>th</sup> edition, John Wiley & Sons, Inc.,

New York/Sydney/Toronto.

George C. Barney, 1988, Intelligent Instrumentation, 2<sup>nd</sup> edition, Prentice Hall,

New York/London/Sydney/Toronto/Tokyo.

Stankovic, D., and Zlatanovic, M., 1994, A versatile computer controlled measuring system for recording voltage-current characteristics of various resistance sensors,

Sensors and Actuators A: Physical, 1994, Vol 42 : 612-616.

## บทความ การแสดงเส้นโค้ง $I_C$ vs $V_{CE}$ ของทรานซิสเตอร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., <sup>2</sup>Physics student, Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

### บทคัดย่อ

ได้แสดงเส้นโค้ง  $I_C$  vs  $V_{CE}$  ของทรานซิสเตอร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

### Abstract

$I_C$  vs  $V_{CE}$  curve of transistor was displayed with LabVIEW Program.

Key words : transistor

### คำนำ

สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 เช่น Si และ Ge พาหะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล จำนวนอิเล็กตรอนกับจำนวนโฮลเท่ากัน สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำชนิด p และสารกึ่งตัวนำชนิด n พาหะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล

สารกึ่งตัวนำชนิด p ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับ อะตอมของธาตุกลุ่ม 3 เช่น Si ผสมกับ B จำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน ( $E_g$ ) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

สารกึ่งตัวนำชนิด n ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับอะตอมของธาตุกลุ่ม 5 เช่น Si ผสมกับ As จำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

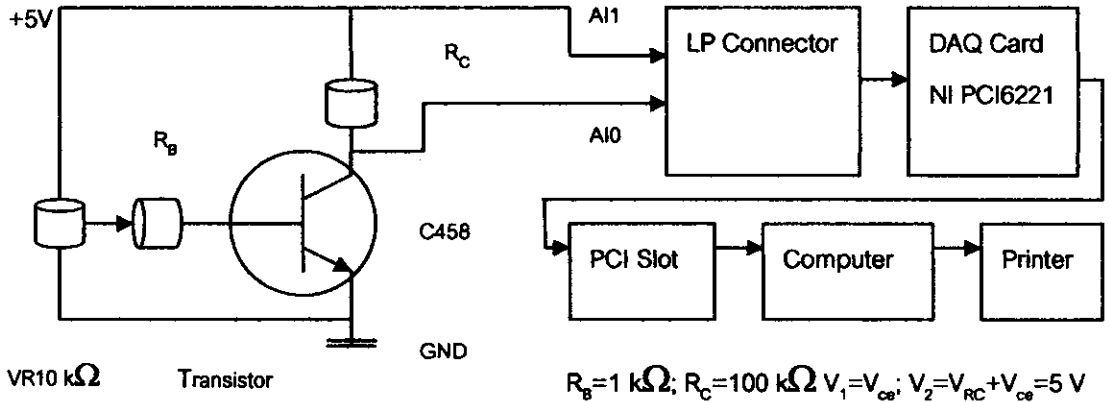
ทรานซิสเตอร์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p ต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิด n ทรานซิสเตอร์มี 2 แบบ คือ แบบ PNP และแบบ NPN ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าและทำหน้าที่เป็นสวิตช์ เมื่อนำทรานซิสเตอร์ไปต่อกับอุปกรณ์อื่นๆก็จะได้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า เกท (gate) ได้

### วิธีการทดลอง

จัดวงจรดังรูปที่ 19.1.3 ให้แรงดันไฟฟ้า V1 และ V12 เข้า A10 และ A11 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card (PCI 6221) เข้าไปในคอมพิวเตอร์ คำนวณ  $V_2 = V_{12} - V_1$ ;  $I_C = I_1 = I = V_2 / 100 \text{ k}\Omega$ ;  $V_{CE} = V_2 =$  แสดงเส้นโค้ง  $I_C$  vs  $V_{CE}$  บนจอ

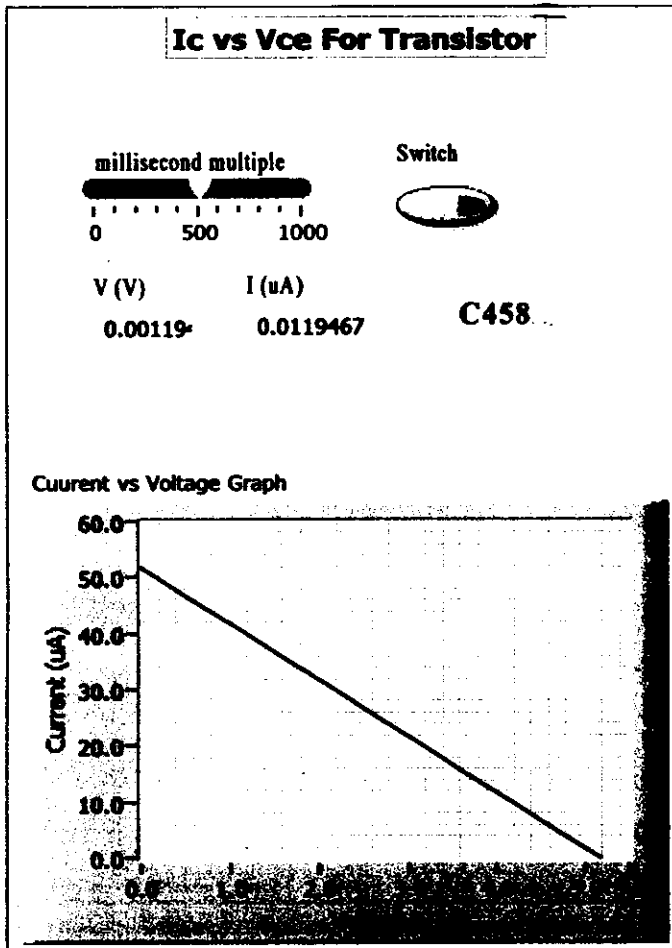
Front Panel และ Block Diagram แสดงดังรูปที่ 19.1.4 DAQ Assistant ทำหน้าที่อ่านแรงดันไฟฟ้า V1 และ V12 ส่งค่า V1 และ V12 ไปที่ Amplitude and Level Measurements ทำหน้าที่จัดปริมาณการวัดเป็นแบบ Mean (DC) ส่งมาที่ Split signal ซึ่งทำหน้าที่แยกแรงดันไฟฟ้าทั้งสองค่าออกจากกัน คำนวณ  $V_2 = V_{12} - V_1$  ด้วย Subtract แล้ว

แสดงผลด้วย Numeric Indicator จำนวนกระแสไฟฟ้า  $I_1(\text{mA}) = V_2/R_2$   $R_2=100 \text{ k}\Omega$  แปลงหน่วยของกระแสไฟฟ้าจาก mA มาเป็น  $\mu\text{A}$  ด้วย Multiply x1000 แสดงค่า I และ V ด้วย Numeric Indicator นำค่า I และ V ไปเขียนกราฟด้วย Build XY Graph Millisecond Multiple เป็นเวลาหน่วง Switch Button เป็น numeric control ทำหน้าที่เปิดปิดสวิทช์ While Loop ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานที่ซ้ำๆกัน ตั้ง RUN เพื่อแสดงผลทั้งหมด สั่งพิมพ์ Front Panel และ Block Diagram ออกทาง Printer



รูปที่ 19.1.4 การวัดเส้นโค้งกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าของทรานซิสเตอร์ที่จอกคอมพิวเตอร์

Th-Tr-IcvsVce.vi  
 D:\0-0a LV III\0002\ADCN' ๑๑'-0๕ 2 #\Th-Tr-IcvsVce.vi  
 Last modified on 12/9/2006 at 10:53 AM  
 Printed on 12/9/2006 at 10:53 AM







19.2 การวัดอัตราขยายที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในขณะที่ความถี่เปลี่ยนของทรานซิสเตอร์  
 บทความ การวัดอัตราขยายแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในขณะที่ความถี่เปลี่ยนของทรานซิสเตอร์  
 , ด้วยโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล

ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ

Thongchai Panmatarn

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

**บทคัดย่อ**

ได้วัดอัตราขยายแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในขณะที่ความถี่เปลี่ยนของทรานซิสเตอร์ด้วยโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล

**Abstract**

Voltage gain versus time as frequency changing of transistor was measured with Turbo Pascal Program.

Key words : transistor

**คำนำ**

สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 เช่น Si และ Ge พาหะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล จำนวนอิเล็กตรอนกับจำนวนโฮลเท่ากัน สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำชนิด p และสารกึ่งตัวนำชนิด n พาหะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล

สารกึ่งตัวนำชนิด p ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับ อะตอมของธาตุกลุ่ม 3 เช่น Si ผสมกับ B จำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน ( $E_g$ ) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

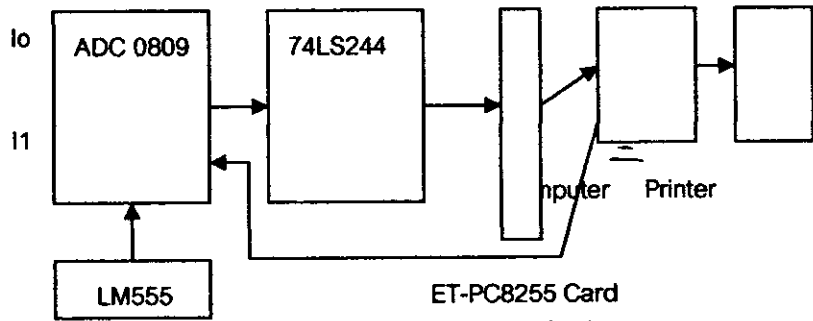
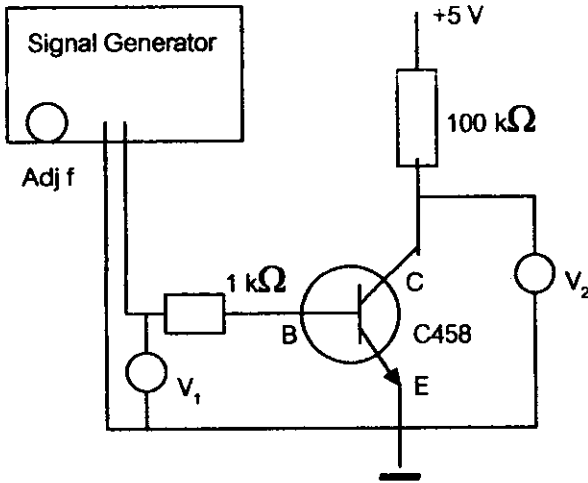
สารกึ่งตัวนำชนิด n ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับอะตอมของธาตุกลุ่ม 5 เช่น Si ผสมกับ As จำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

ทรานซิสเตอร์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p ต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิด n ทรานซิสเตอร์มี 2 แบบ คือ แบบ PNP และแบบ NPN ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าและทำหน้าที่เป็นสวิตช์ เมื่อนำทรานซิสเตอร์ไปต่อกับอุปกรณ์อื่นๆก็จะได้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า เกท (gate) ได้

**วิธีการทดลอง**

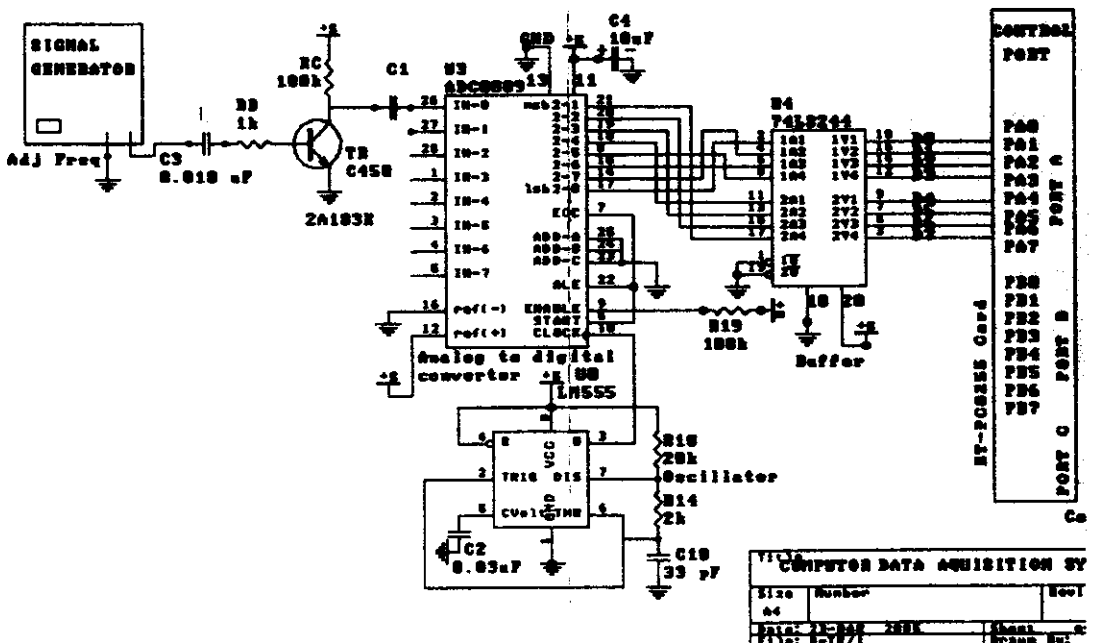
จัดการทดลองตามรูปที่ 19.2.1 จ่ายแรงดันไฟฟ้าตรงจาก DC Power Supply ไปยังทรานซิสเตอร์ ป้อนแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าเข้าขา B ของทรานซิสเตอร์ ทรานซิสเตอร์ขยายสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งออก

ทางขา C ใช้มัลติมิเตอร์ (Fluke 45) วัดแรงดันไฟฟ้าอินพุท  $V_1$  และแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุท  $V_2$  ที่ความถี่  $f$  เพิ่มความถี่แล้วบันทึกผลทั้งหมดลงในตารางที่ 1 คำนวณ Voltage gain ( $G = V_2/V_1$ ) นำค่าไปเขียนเส้นโค้ง  $G$  vs  $f$  พร้อมทั้งแสดงผลการด้วย EXCEL



รูปที่ 19.2.1(n) การวัดอัตราขยายที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในขณะที่ความถี่เปลี่ยนแปลง

HPF TEST FOR INDUCTOR



รูปที่ 19.2.1(ข) วงจรสำหรับการวัดอัตราขยายที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในขณะที่ความถี่เปลี่ยนแปลง

Program Voltage\_vs\_Time\_as\_frequency\_change\_Graph;

uses crt, graph;

var grdrv, grmode, grrror : integer;

ch : char;

const PA = \$0304;

Pcontrol = \$0307;

procedure axis;

var p,q : integer;

tex : string;

begin

grdrv:=detect ; initgraph(grdrv,grmode,'c:\tp\bgi');

setgraphmode(grmode);

line(50,50,50,305) ; line(50,305,600,305);

line(50,50,600,50) ; line(600,50,600,305);

settextstyle(defaultfont , horizdir,0);

for p := 50 to 600 do

begin

if p mod 32 = 0 then

begin

line(p+18, 295, p+18, 305); str(round(p/32-1),tex);

outtextxy(p+18, 320, tex);

end;

end;

settextstyle(defaultfont , horizdir,0);

for q:= 50 to 305 do

begin

line(45,q,55,q) ; str(((305-q) mod 5)+1, tex); outtextxy(20,q,tex)

end;

end;

procedure plot ;

var i, x, y, DV : integer;

AV : real;

begin

outtextxy(235,10, Voltage\_vs\_Time\_as\_frequency\_change\_Graph' );

outtextxy(235,18, \_\_\_\_\_);

outtextxy(50,30, Temperature (°C));

```

outtextxy(540,340,time (s));
outtextxy(48,303,"");
begin
  port [Pcontrol ]:=$90;
  for i:=0 to 550 do
    begin
      DV:=port[PA];
      AV:=(5/255)*DV;
      x:=j+50 ; y:=305-DV;
      lineto(x,y);
      delay(30)
    end;
  end;
  readln;
  closegraph;
end;
begin (main)
  repeat
    axis;
    plot;
    ch:=readkey;
  until ord(ch) = 27;
end.

```

**ผลการทดลอง**

รูปที่ 19.2.2 การวัดอัตราขยายที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในขณะที่มีความถี่เปลี่ยนแปลงได้ (G vs t) ของทรานซิสเตอร์

### วิเคราะห์ผลการทดลอง

การวัดอัตราขยายที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในขณะที่ความถี่เปลี่ยนแปลง (G vs f) ของทรานซิสเตอร์เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายสัญญาณไฟฟ้า

### สรุปผลการทดลอง

ได้วิธีการวัดอัตราขยายที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาในขณะที่ความถี่เปลี่ยนแปลง

### เอกสารอ้างอิง

ดุสิต เครื่องาม และคณะ คู่มือปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525

ดุสิต เครื่องาม โขลิตเสตทพิสิทส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2535

Charles Kittel, 1976, Introduction to Solid State Physics, 5<sup>th</sup> edition, John Wiley & Sons, Inc.,

New York/Sydney/Toronto.

### 19.3 การวัดอัตราขยายที่ขึ้นกับความถี่ของทรานซิสเตอร์

บทความ การวัดอัตราขยายแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความถี่ของทรานซิสเตอร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

### ธงชัย พันธุ์เมธาฤทธิ์

Thongchai Panmatarith

M.Sc. (Solid State Physics), Assoc. Prof., Materials Physics Laboratory,

Department of Physics, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, 90112 Thailand.

Corresponding e-mail : tongchai.p@psu.ac.th

### บทคัดย่อ

ได้แสดงการวัดอัตราขยายแรงดันไฟฟ้าที่ขึ้นกับความถี่ของทรานซิสเตอร์ด้วยโปรแกรมแลปวิว

### Abstract

Voltage gain versus frequency of transistor was measured with LabVIEW Program.

Key words : transistor

### คำนำ

สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 เช่น Si และ Ge พานะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล จำนวนอิเล็กตรอนกับจำนวนโฮลเท่ากัน สารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์มี 2 ประเภท คือ สารกึ่งตัวนำชนิด p และสารกึ่งตัวนำชนิด n พานะไฟฟ้าเป็นอิเล็กตรอนและโฮล

สารกึ่งตัวนำชนิด p ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับ อะตอมของธาตุกลุ่ม 3 เช่น Si ผสมกับ B จำนวนอิเล็กตรอนน้อยกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน ( $E_g$ ) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

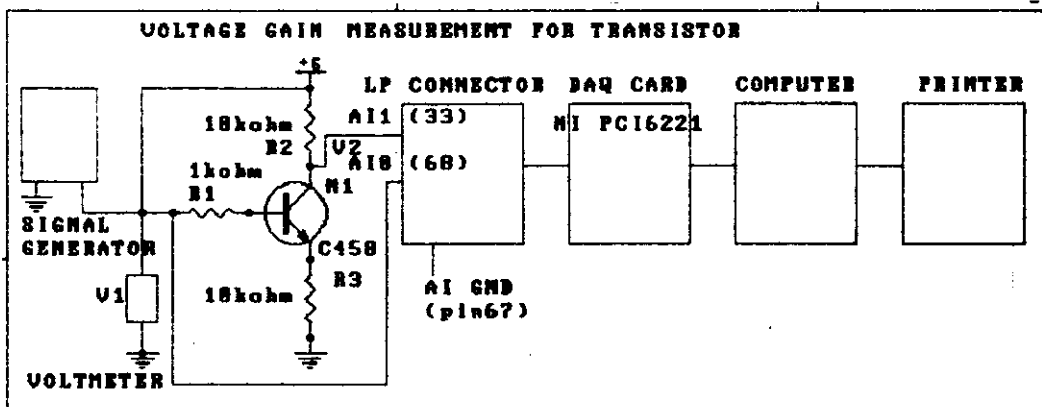
สารกึ่งตัวนำชนิด n ทำมาจากอะตอมของธาตุกลุ่ม 4 ผสมกับอะตอมของธาตุกลุ่ม 5 เช่น Si ผสมกับ As จำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโฮลเท่ากัน ความต้านทานไฟฟ้าของสารจะขึ้นกับปริมาณอิเล็กตรอนกับโฮลและช่องว่างแถบพลังงาน เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ย้ายไปยังแถบการนำมีโฮลเกิดขึ้นในแถบวาเลนซ์ อิเล็กตรอนและโฮลที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในขณะที่สารได้รับสนามไฟฟ้าจากภายนอก

ทรานซิสเตอร์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิด p ต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิด n ทรานซิสเตอร์มี 2 แบบ คือ แบบ PNP และแบบ NPN ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าและทำหน้าที่เป็นสวิตช์ เมื่อนำทรานซิสเตอร์ไปต่อกับอุปกรณ์อื่นๆจะได้อุปกรณ์ที่มีชื่อว่า เกท (gate) ได้

### วิธีการทดลอง

จัดวงจรดังรูปที่ 19.3.1 ปลอ่ยแรงดันไฟฟ้า V1 จากเครื่องกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าเข้าขา B ทรานซิสเตอร์ขยายแรงดันไฟฟ้านี้ซึ่งได้ค่า V2 แล้วส่งออกทางขา C ให้แรงดันไฟฟ้า V1 และ V2 เข้า AI0 และ AI1 ของ LP connector ผ่าน DAQ Card (PCI 6221) เข้าไปในคอมพิวเตอร์ คำนวณอัตราขยายแรงดันไฟฟ้า (A) ที่ความถี่ f ต่างๆ

Front Panel และ Block Diagram แสดงดังรูปที่ 19.3.2 DAQ Assistant จัดการเกี่ยวกับการรับแรงดันไฟฟ้า V1 และ V2 มาเข้าที่ Absolute Value เพื่อทำให้ค่าเป็นบวก ส่งค่าไปที่ Amplitude and Level Measurements ทำหน้าที่จัดปริมาณการวัดเป็นแบบ Rms ส่งมาที่ Split signal ซึ่งทำหน้าที่แยกแรงดันไฟฟ้าทั้งสองค่าออกจากกัน นำแรงดัน V1 และ V2 มารวมด้วย Divide ก็จะได้อัตราขยายแรงดันไฟฟ้า (voltage gain, G) ส่งค่า G ไปที่ Merge Signal นำแรงดันที่ผ่าน Absolute Value มาเข้าที่ Tone Measurement เพื่อวัดความถี่ f โดยแสดงผลด้วย Numeric Indicator ส่งค่า f ไปที่ Merge Signal ค่า G และ f จาก Merge Signal จะมาเข้าที่ Build Table เพื่อแสดงกราฟของ G vs f ด้วย Table นี้ Millisecond Multiple เป็นเวลาหน่วย Stop Button เป็น numeric control ทำหน้าที่เปิดปิดสวิตช์ For Loop ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานที่ซ้ำๆกัน สั่ง RUN เพื่อแสดงผลทั้งหมด สั่งพิมพ์ Front Panel และ Block Diagram ออกทาง Printer



รูปที่ 19.3.1 การจัดการชุดการทดลองสำหรับการวัดอัตราขยายที่ขึ้นกับความถี่ของทรานซิสเตอร์



## ผลการทดลอง

ผลการวัดอัตราขยายที่ขึ้นกับความถี่ของทรานซิสเตอร์แสดงดังรูปที่ 19.3.2

## วิเคราะห์ผลการทดลอง

ผลการวัดอัตราขยายที่ขึ้นกับความถี่ของทรานซิสเตอร์จะเป็นข้อมูลสำหรับใช้พิจารณาความถี่ใช้งานที่เหมาะสมของทรานซิสเตอร์

## สรุปผลการทดลอง

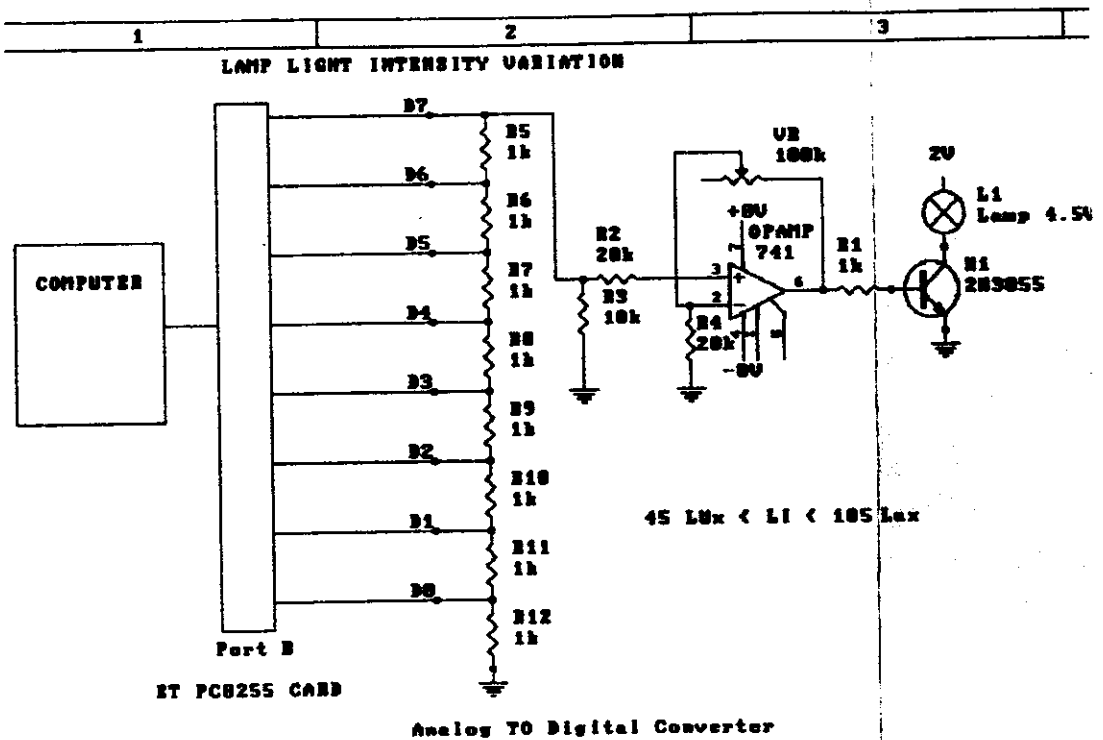
ระบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมด้วย LabVIEW สามารถแสดงผลการวัดอัตราขยายที่ขึ้นกับความถี่ของทรานซิสเตอร์

## เอกสารอ้างอิง

Charles Kittel, 1976, Introduction to Solid State Physics, 5<sup>th</sup> edition, John Wiley & Sons, Inc.,  
New York/Sydney/Toronto.

## 19.4 การแปลงดิจิตอลเป็นอนาลอกสำหรับควบคุมความเข้มแสงของหลอดไฟฟ้า

การศึกษากการแปลงดิจิตอลเป็นอนาลอกสำหรับควบคุมความเข้มแสงของหลอดไฟฟ้าทำได้โดยการให้คอมพิวเตอร์ส่งแรงดันดิจิตอลที่แปรค่าได้ออกทางพอร์ต B ของ ET-PC8255 card มายังวงจรแปลงแรงดันดิจิตอลเป็นแรงดันอนาลอก (DAC circuit) ส่งต่อไปยังออปแอมป์ 741 เพื่อขยายแรงดันไฟฟ้านี้แล้วส่งมายังขา B ของทรานซิสเตอร์ 2N3055 เพื่อรับหลอดไฟฟ้าขนาด 4.5 V ขณะที่แรงดันไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์ส่งออกมาเปลี่ยนแปลง ความเข้มแสงของหลอดไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนแปลง โปรแกรมที่ควบคุมการทำงานเป็นโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล V7.0





โปรแกรมสำหรับการแปลงดิจิตอลเป็นอนาลอกสำหรับควบคุมความเข้มแสงของหลอดไฟฟ้า**โปรแกรม การแปลงระดับดิจิตอลเป็นระดับอนาลอก**

Program Digital\_Analog\_Conversion\_2549;

Uses crt, graph;

Var

Grdrv, grmode, gerror : integer;

Ch : char;

Const PA = \$0304;

PB = \$0305;

Pcontrol = \$0307;

Procedure axis;

Var p,q : integer;

Text : string;

Begin

Grdrv := detect; initgraph(grdrv, grmode, 'c:\tp\lgi');

Setgraphmode(grmode);

Setcolor(15); line(50,50,50,305); line(50,305,600,305);

line(50,50,600,50); line(600,50,600,305);

settextstyle(defaultfont, horizdir,0)

for p:=50 to 600 do

begin

if p mod 32 = 0 then

begin

line(p+18,295,p+18,305); str(round(p/32-1),tex);

outtextxy(p+18,320,tex);

end;

setcolor(15); settextstyle(defaultfont, horizdir,0);

for q:=50 to 305 do

begin

if q mod 51 = 0 do then

begin

line(45,q,55,q); str(((305-q) mod 5)+1,tex);

outtextxy(20,q,tex);

end;

end;

end;

```

end;
procedure plot;
var i,x,y,DV : integer
    AV       : real;
begin
    setcolor(3); outtextxy(175,10,'DIGITAL TO ANALOG CONVERSION 2549);
    setcolor(3); outtextxy(175,18,'-----');
    setcolor(5); outtextxy(50,30,'Voltage (V)');
    setcolor(5); outtextxy(540,340,'Time (s)');
    setcolor(5); outtextxy(48,303,'');
    port[Pcontrol]:=90;
    For i:=0 to 255 do
        Begin
            i:=0;
            repeat
                Port[PB]:=i;
                Delay(15);
                X:=i+50; y:=255-i+50;
                line(x,y,x,y);
                Delay(100);
                i:=i+5
            Until i = 255
        End;
    For i:=255 to 510 do
        Begin
            i:=255;
            repeat
                Port[PB]:=(510-i);
                Delay(15);
                X:=i+50; y:=(255-i)+50;
                line(x,y,x,y);
                Delay(100);
                i:=i+5
            Until i = 510
        End;
    End;
End;

```

618(1)

Readln;

Closegraph;

Begin

repeat

axis;

plot;

ch:=readkey;

until ord(ch) = 27;

End.